

## ПРАВИЛА ОТБОРА ДЛЯ РАДИАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ В ОТКРЫТЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ

© 2013 Н. В. Королев, С. Е. Стародубцев, Е. Н. Бормонтов, А. Ф. Клиньских

*Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, 394006 Воронеж, Россия*

Поступила в редакцию 01.04.2013 г.

**Аннотация.** В рамках модели открытой сферической квантовой точки с дельта-потенциалом на границе рассчитана энергетическая структура рассматриваемой системы в режиме сильного конфайнмента, представляющая собой квазистационарные электронные состояния и стационарные состояния тяжелых и легких дырок. На основе полученного спектра и волновых функций рассчитан интеграл перекрытия как величина, характеризующая правила отбора для межзонных оптических переходов. Показано, что значения интеграла перекрытия для открытой квантовой системы в сравнении с закрытой, претерпевают как количественные, так и качественные изменения. В частности, для переходов из состояний легких дырок в электронные состояния становятся разрешенными все переходы с сохранением орбитального квантового числа независимо от радиального квантового числа.

**Ключевые слова:** открытая квантовая точка, спектр квазистационарных состояний, интеграл перекрытия, межзонные оптические переходы.

### ВВЕДЕНИЕ

Оптические методы исследования квантовых точек (КТ), такие как наведенное поглощение, люминесцентная спектроскопия [1, 2] направлены на изучение как фундаментальных закономерностей физических свойств нульмерных систем [3], так и на определение возможных областей их практического применения [4—8].

Если рассматривать исключительно электронно-дырочные состояния КТ, то основным инструментом исследования является методика измерения спектров поглощения, которая характеризует оптические межзонные переходы. В первом приближении межзонные переходы между стационарными состояниями электрона и дырки для однородных параболических зон были рассмотрены в работе [9], в которой сформулировано правило отбора по орбитальному и радиальному квантовым числам. Развитием данного подхода явилось включение в модель неоднородности энергетического спектра в области, соответствующей валентной зоне объемного полупроводника, а именно вырождение для состояний легких и тяжелых дырок [10]. Однако наиболее адекватным экспериментальным результатам является рассмотрение трехкратно вырожденных дырочных состояний с учетом спин-орбитального взаимодействия [11].

Вместе с этим, разработаны и другие подходы к моделированию энергетической структуры КТ, основанные на приближении сильной связи [12], полуэмпирического псевдопотенциала [13] и локального функционала плотности [14].

Однако указанные методики расчета энергетической структуры и правил отбора оперируют с величинами, отвечающими стационарным состояниям квазичастиц, тогда как уширение уровней, присущее всем открытым квантовым системам [15, 16], либо не учитывается, либо вводится как феноменологическая поправка в конечных выражениях. Отметим, что вопрос о влиянии дополнительных каналов релаксации на правила отбора в межзонных оптических переходах ранее подробно не обсуждался.

Одной из задач данной работы является анализ квазистационарной природы энергетического спектра и ее влияние на правила отбора в межзонных оптических переходах. Для этого предложена модель открытой сферической квантовой точки, в которой учитывается вероятность туннельного ухода электрона в окружающую среду (матрицу), а также двукратное вырождение энергетических состояний дырок. Анализ правила отбора проводился на основе интеграла перекрытия волновых функций электронных и дырочных состояний.

### ЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТР

Рассмотрим КТ как открытую квантовую систему, особенности спектра которой будут определяться потенциалом на границе КТ и окружающей среды. Потенциал выбирается в виде:

$$U(r) = \Theta \cdot \delta(r - r_0) \quad (1)$$

с коэффициентом проницаемости  $\Theta$ , который может быть выражен в параметрах высоты  $a$  и ширины  $b$  прямоугольного потенциального барьера  $\Theta \approx ab / \pi$  [17].

Энергетический спектр электрона рассчитывался на основе решения сферически симметричного уравнения Шредингера в приближении эффективной массы  $E(k)$ . Базовым являлся анализ трансцендентного уравнения [18]:

$$\frac{m_2 j_{l+1}(k_1 r_0)}{m_1 j_l(k_1 r_0)} - \frac{k_1 h_{l+1}^{(1)}(k_2 r_0)}{k_2 h_l^{(1)}(k_2 r_0)} - \frac{2m_2 \Theta}{k_1 \hbar^2} + \frac{l}{k_1 r_0} \left( 1 - \frac{m_2}{m_1} \right) = 0 \quad (2)$$

Здесь  $j_l(kr)$ ,  $h_l^{(1)}(kr)$  сферические функции Бесселя и Ханкеля первого рода [19],  $l$  — орбитальное квантовое число,  $m_{1,2}$  — эффективная масса электрона в КТ матрице. Решения уравнения (2) представляют собой квазистационарный спектр  $\tilde{E}_{nl}^O = E_{nl}^O - i\Gamma_{nl}/2$ , где  $E_{nl}^O$  является аналогом стационарных значений энергий, а  $\Gamma_{nl}$  — уширение квазистационарных состояний, определяемое вероятностью туннельного ухода электрона из КТ;  $n$  — радиальное квантовое число, определяющее порядок корней функции Бесселя. Поправка на кулоновское взаимодействие между электроном и дыркой не учитывалась, поскольку ее величина в представленном формализме не вносит изменения в правила отбора межзонных переходов.

Отметим, что спектр для закрытой сферической КТ  $E_{nl}^C$  был получен как частный случай из трансцендентного уравнения  $j_l(k_1 r_0) = 0$ .

$$\psi_{FM}(r, \theta, \phi) = \sqrt{2F+1} \sum_l (-1)^{l-3/2+M} R_{Fl}(r) \sum_{m\mu} \begin{pmatrix} l & 3/2 & F \\ m & \mu & -M \end{pmatrix} Y_{lm}(\theta, \phi) \chi_{\mu} \quad (5)$$

где  $\chi_{\mu}$  — компоненты волновой функции Блоха в области  $\vec{k} = 0$ . При заданном значении

### ДЫРОЧНЫЙ СПЕКТР

В случае коллоидных КТ область спектра, соответствующую валентной зоне объемного полупроводника, можно описать сферически симметричным гамильтонианом в приближении бесконечно глубокой потенциальной ямы, полученным в работе [20] и подробно рассмотренным в [21].

При условии  $\gamma_2 = \gamma_3$  и сильного спин-орбитального расщепления данный гамильтониан представляет собой выражение:

$$H = \frac{1}{2m_0} \left[ \left( \gamma_1 + \frac{5}{2} \gamma_2 \right) \hat{p}^2 - 2\gamma_2 \left( \hat{p} \cdot \hat{J} \right)^2 \right], \quad (3)$$

где  $\gamma_{1,2}$  — эмпирические параметры Латтинжера (параметры эффективной массы),  $m_0$  — масса свободного электрона,  $\hat{J}$  — оператор момента импульса, соответствующий значению  $j = 3/2$  [21, 22].

Непосредственно для вычисления дырочного спектра удобно выражение (3) представить в матричном виде путем вычисления матричных элементов по ортогональным волновым функциям момента импульса для проекций  $m_j = \pm 3/2, \pm 1/2$ :

$$\langle jm' | H | jm \rangle = \frac{1}{2m_0} \begin{vmatrix} P+Q & L & M & 0 \\ L^* & P-Q & 0 & M \\ M^* & 0 & P-Q & -L \\ 0 & M^* & -L^* & P+Q \end{vmatrix}, \quad (4)$$

где  $P = \gamma_1 p^2$ ,  $Q = \gamma_2 (p_x^2 - 2p_z^2)$ ,  $M = \sqrt{3} \gamma_2 p_x p_z$ ,

$L = -2i\sqrt{3} \gamma_2 p_x p_y$ . При этом  $P$  соответствует закону дисперсии свободной частицы в поле кристаллической решетки;  $Q$ ,  $L$  и  $M$  описывают эффект анизотропии энергетической (валентной) зоны.

Вид волновых функций с использованием коммутирующего с гамильтонианом полного момента импульса  $\vec{F} = \vec{L} + \vec{J}$  для отдельной дырки приводился ранее в ряде работ. Так, например, в [22] с использованием  $3j$ -символов Вигнера [23] волновая функция была записана в виде:

$F = 1/2, 3/2, 5/2, \dots$  величина  $l$  может принимать четыре значения  $l = F \pm 3/2$  и  $l = F \pm 1/2$ , за

исключением случая  $F = 1/2$ , когда возможны лишь значения  $l = 1, 2$ . Вид волновой функции (5) отвечает задаче сложения моментов, что, в свою очередь, подчеркивает важность взаимосвязи отдельных подсистем.

Используя технику приведенных матриц, из (4) можно получить системы дифференциальных уравнений на радиальные волновые функции [22, 24], решения которых в общем случае представляют собой суперпозицию сферических функций Бесселя для четных:

$$\begin{aligned} R_{F,F+1/2}(r) &= Aj_{F+1/2}(k_{hh}r) + Bj_{F+1/2}(k_{lh}r) \\ R_{F,F-3/2}(r) &= A'j_{F-3/2}(k_{hh}r) + B'j_{F-3/2}(k_{lh}r), \end{aligned} \quad (6)$$

и нечетных состояний:

$$\begin{aligned} R_{F,F-1/2}(r) &= Aj_{F-1/2}(k_{hh}r) + Bj_{F-1/2}(k_{lh}r) \\ R_{F,F+3/2}(r) &= A'j_{F+3/2}(k_{hh}r) + B'j_{F+3/2}(k_{lh}r), \end{aligned} \quad (7)$$

с заменой  $F$  на  $-(F+1)$  в значении косинуса  $\cos(\alpha_F) = (2F-3)/4$ ;  $A' = A \operatorname{tg}(\alpha_F/2)$ ,  $B' = -B \operatorname{ctg}(\alpha_F/2)$  [10, 25]. Здесь  $m_l = m_0/(\gamma_1 + 2\gamma_2)$  и  $m_h = m_0/(\gamma_1 - 2\gamma_2)$  — эффективные массы легкой и тяжелой дырок.

Условие равенства нулю волновых функций (6) и (7) на границе КТ вместе с нормировкой на дискретный спектр позволяют определить коэффициенты  $A$  и  $B$ , а условие разрешимости систем дает трансцендентные уравнения на спектр четных:

$$\begin{aligned} j_{F+1/2}(k_{hh}r_0)j_{F-3/2}(k_{lh}r_0) + \\ + \frac{6F-3}{2F+3}j_{F-3/2}(k_{hh}r_0)j_{F+1/2}(k_{lh}r_0) = 0 \end{aligned} \quad (8)$$

и нечетных дырочных состояний:

$$\begin{aligned} j_{F-1/2}(k_{hh}r_0)j_{F+3/2}(k_{lh}r_0) + \\ + \frac{6F+9}{2F-1}j_{F+3/2}(k_{hh}r_0)j_{F-1/2}(k_{lh}r_0) = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

### ИНТЕГРАЛ ПЕРЕКРЫТИЯ

Интеграл перекрытия волновых функция двух состояний является количественной характеристикой радиационного перехода, наблюдаемого между этими состояниями. Так, отличные от нуля значения интеграла перекрытия определяют правила отбора для переходов в системе. Абсолютное значение интеграла перекрытия характеризует относительную интенсивность спектральных линий, а

также силу осциллятора соответствующего перехода. Используя явное выражение для модуля интеграла перекрытия в приближении медленных огибающих функций:

$$\left| \int \psi_{nl}^e(\vec{r})^* \psi_{nFM}^h(r) d^3r \right| \quad (10)$$

с учетом конкретного вида волновых функций, можно проанализировать правила отбора для радиационных переходов в открытой КТ в сравнении с закрытой. К примеру, для основного перехода  $1S_{3/2} \rightarrow 1S_e$  интеграл перекрытия принимает вид:

$$\left| \int C_1^*(r_0) j_0(k_e r) Y_{0,0}^* \left[ \begin{aligned} &R_{3/2,0}(r) Y_{0,0} + \\ &+ \sqrt{\frac{2}{5}} R_{3/2,2}(r) \\ &\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{2,0} - Y_{2,1} + Y_{2,2} \right\} \end{aligned} \right] d^3r \right|,$$

где  $Y_{l,m} \equiv Y_{l,m}(\theta, \phi)$  — сферическая функция.

### ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Численное решение уравнений на спектр (8) и (9) проводилось для КТ CdS с радиусом  $r_0 = 2.06$  нм, окруженной желатиновой матрицей при следующих физических параметрах системы:  $m_l = 0.205m_0$ ,  $m_h = m_0$  [18] ( $m_0$  — масса свободного электрона),  $E_g(\text{CdS}) = 2.42$  эВ,  $\gamma_1 = 1.31$  [11],  $\gamma_2 = 0.34$  [25],  $\Theta \sim 10^{-6}$  эВ·см.

Характер изменения энергетического спектра КТ в зависимости от ее размера представлен на рис. 1, где сплошная и пунктирная линии соответствуют энергетическим состояниям тяжелой и легкой дырок, а заштрихованные области представляют первые квазистационарные состояния электрона  $1S_e$ ,  $1P_e$ ,  $1D_e$  с шириной  $\Gamma_{ll}$ . Для сравнения на рис. 1 также обозначены электронные состояния закрытой сферической КТ (штрихпунктирная линия).

Как в закрытой, так и в открытой КТ для разрешенных межзонных переходов из состояний тяжелой дырки  $nS_{3/2}$  и  $nP_{3/2}$  выполняется правило отбора по орбитальному квантовому числу  $\Delta l = 0, 2$  (табл. 1). Разница в абсолютных значениях интеграла перекрытия (10) связана с характером волновых функций квазистационарных состояний в открытой КТ, отражающих возможное взаимодействие с окружением (рис. 1). Аналогичная зависимость сохраняется и для состояний с  $F = 5/2$  и  $F = 7/2$

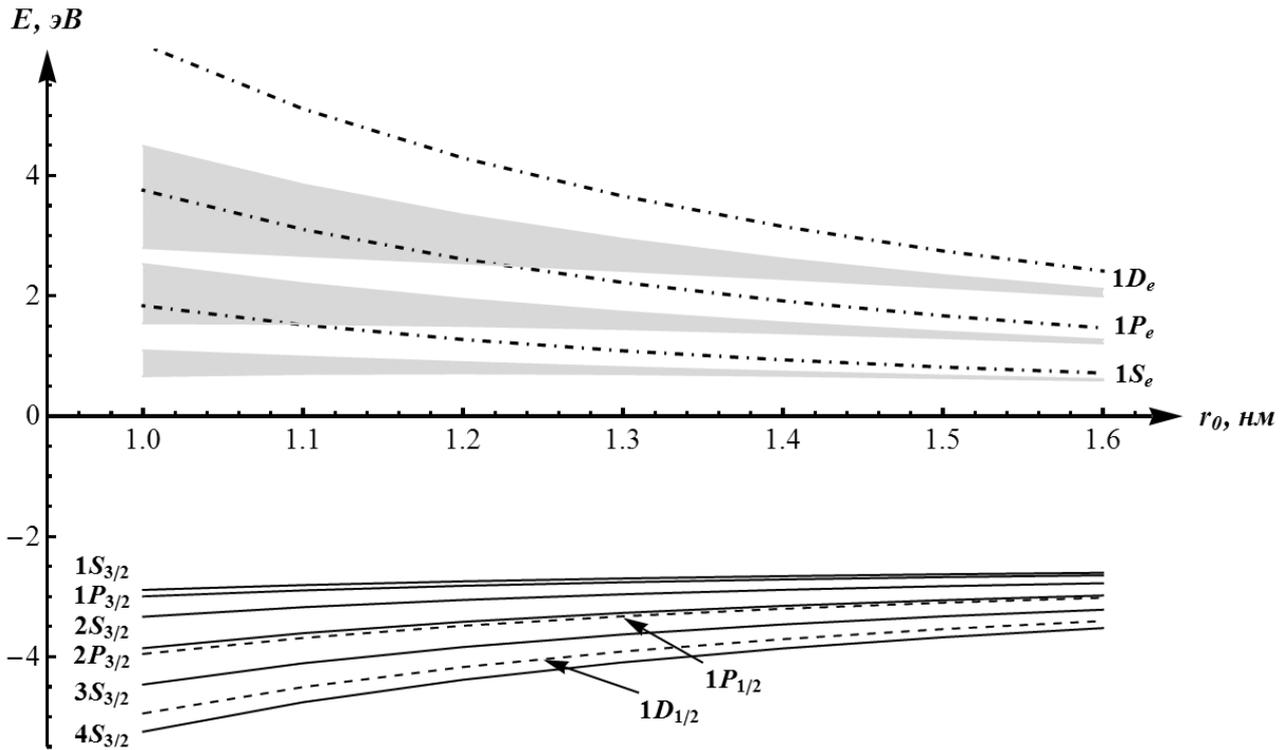


Рис. 1. Электронный  $E_n$  и дырочный  $E_{nF}$  спектры КТ CdS как функция размера частицы  $r_0$

Интеграл перекрытия между волновыми функциями легкой дырки и электрона в закрытой КТ определяет правило отбора межзонных переходов с условием  $\Delta l = 0$  и  $\Delta n = 0$ . Вместе с этим, в открытой КТ правило отбора для этих переходов претерпевает изменения, а именно, разрешенными становятся все переходы с  $\Delta l = 0$  независимо от радиального квантового числа (табл. 2). Такое изменение правила отбора в открытых системах связано с учетом дополнительных каналов релаксации энергии, импульса, отвечающих процессам затухания амплитуды и фазы. Отметим, что рассмотренный интеграл перекрытия характеризует затухание амплитуды, аналогично процессу спонтанного излучения.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе на основе модели открытой сферической квантовой точки, учитывающей квазистационарный характер энергетических состояний электрона и двукратное вырождение дырочных состояний, проведен анализ возможного влияния окружения (матрицы) на правила отбора межзонных переходов. Оказалось, что учет уширения электронных состояний приводит к перераспределению значений интеграла перекрытия и сведению правила отбора межзонных переходов из состояний

легкой дырки к условию  $\Delta l = 0$ . Такая особенность в правиле отбора связана, в первую очередь, с учетом дополнительного канала релаксации импульса, а во-вторых, с симметрией волновых функций.

Данный результат делает актуальным дальнейшее развитие исследований оптических свойств квантовых точек с позиции открытых квантовых систем. Расчет фундаментального края поглощения с учетом спин-орбитального расщепления дырочных состояний планируется выполнить в следующей работе.

*Работа выполнена при поддержке программы стратегического развития ВГУ для молодых исследователей (№ ПСР-МГ/09-12).*

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Reiss P., Protiere N., Li L. // *Small*. 2009. V. 5. № 2. P. 154.
2. Bera D., Qian L., Tseng T.— K., et al. // *Materials*. 2010. V. 3. P. 2260.
3. Woggon U. *Optical properties of semiconductor quantum dots*. Berlin, 1997. 251 p.
4. Hewa-Kasakarage N. N., El-Khoury P. Z., Tarvovsky A. N., et al. // *ACS Nano*. 2010. V. 4. № 4. P. 1837.
5. Deka S., Quarta A., Lupo G. M., et al. // *J. Am. Chem. Soc.* 2009. V. 131. № 8. P. 2948.
6. Anikeeva P. O., Halper J. E., Bawendi M. G., et al. // *Nano Lett.* 2009. V. 9. № 7. P. 2532.

ПРАВИЛА ОТБОРА ДЛЯ РАДИАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ В ОТКРЫТЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ

**Таблица 1.** Абсолютные значения интеграла перекрытия для волновых функций состояний тяжелой дырки и электрона в закрытой/открытой КТ

Переходы	$1S_{3/2}$	$2S_{3/2}$	$3S_{3/2}$	$1P_{3/2}$	$2P_{3/2}$	$3P_{3/2}$
$\rightarrow 1S_e$	$\frac{0.9774}{0.9054}$	$\frac{0.2050}{0.3314}$	$\frac{0.0408}{0.0872}$	0.0	0.0	0.0
$\rightarrow 1P_e$	0.0	0.0	0.0	$\frac{0.2796}{0.3717}$	$\frac{0.4980}{0.4371}$	$\frac{0.0955}{0.0448}$
$\rightarrow 1D_e$	$\frac{0.0811}{0.0781}$	$\frac{0.3312}{0.2995}$	$\frac{0.0775}{0.1522}$	0.0	0.0	0.0
$\rightarrow 2S_e$	$\frac{0.1047}{0.3711}$	$\frac{0.6387}{0.5213}$	$\frac{0.1825}{0.0345}$	0.0	0.0	0.0
$\rightarrow 1F_e$	0.0	0.0	0.0	$\frac{0.1326}{0.1100}$	$\frac{0.0500}{0.0667}$	$\frac{0.0018}{0.0272}$
$\rightarrow 2P_e$	0.0	0.0	0.0	$\frac{0.2035}{0.1854}$	$\frac{0.0635}{0.1863}$	$\frac{0.4856}{0.4785}$
$\rightarrow 2D_e$	$\frac{0.0098}{0.0224}$	$\frac{0.0169}{0.1393}$	$\frac{0.3165}{0.2461}$	0.0	0.0	0.0

**Таблица 2.** Абсолютные значения интеграла перекрытия для волновых функций состояний легкой дырки и электрона в закрытой/открытой КТ

Переходы	$1P_{1/2}$	$2P_{1/2}$	$1D_{1/2}$	$2D_{1/2}$
$\rightarrow 1S_e$	0.0	0.0	0.0	0.0
$\rightarrow 1P_e$	$\frac{0.5774}{0.5392}$	$\frac{0.0}{0.1410}$	0.0	0.0
$\rightarrow 1D_e$	0.0	0.0	$\frac{0.2154}{0.1984}$	$\frac{0.0}{0.1115}$
$\rightarrow 2S_e$	0.0	0.0	0.0	0.0
$\rightarrow 1F_e$	0.0	0.0	0.0	0.0
$\rightarrow 2P_e$	$\frac{0.0}{0.1962}$	$\frac{0.5774}{0.5051}$	0.0	0.0
$\rightarrow 2D_e$	0.0	0.0	$\frac{0.0}{0.0811}$	$\frac{0.4232}{0.3652}$

7. Klimov V. I., Mikhailovsky A. A., Xu S., et al. // Science. 2000. V. 290. P. 314
8. Oertel D. C., Bawendi M. G., Arango A. C., et al. // Appl. Phys. Lett. 2005. V. 87. № 21. P. 213505.
9. Эфрос Ал. Л., Эфрос А. Л. // ФТП. 1982. Т. 16. Вып. 7. С. 1209.
10. Екимов А. И., Онущенко А. А., Плюхин А. Г. и др. // ЖЭТФ. 1985. Т. 88. Вып. 4. С. 1490.
11. Григорян Г. Б., Казарян Э. М., Эфрос Ал. Л. и др. // ФТТ. 1990. Т. 32. Вып. 6. С. 1772.
12. Schulz S., Mourad D., Schumacher S., et al. // Phys. Status Sol. B. 2011. V. 248. № 8. P. 1853.
13. Schrier J., Wang L.— W. // Phys. Rev. B. 2006. V. 73. № 24. P. 245332.
14. Mavros M. G., Micha D. A., Kilin D. S. // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. № 40. P. 19529.
15. Scully M. O., Zubairy M. S. Quantum optics. Cambridge, 1997. 630 p.
16. Breuer H.—P., Petruccione F. Theory of open quantum systems. Oxford, 2002. 645 p.
17. Королев Н. В., Стародубцев С. Е., Бормонтов Е. Н. и др. // КСМГ. 2011. Т. 13. № 1. С. 67.
18. Korolev N. V., Starodubtcev S. E., Klinskikh A. F., et al. // J. Nano- Electron. Phys. 2013. V. 5. № 1. P. 01001.
19. Бейтман Г. Высшие трансцендентные функции. М.: Наука, 1969. 296 с.
20. Luttinger J. M. // Phys. Rev. 1956. V. 102. № 4. P. 1030.
21. Baldereschi A., Lipari N. O. // Phys. Rev. B. 1973. V. 8. № 6. P. 2697.
22. Гельмонт Б. Л., Дьяконов М. И. // ФТП. 1971. Т. 5. Вып. 11. С. 2191.
23. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. М.: Физматлит, 2004. 800 с.
24. Xia J.— B. // Phys. Rev. B. 1989. V. 40. № 12. P. 8500.
25. Richard T., Lefebvre P., Mathieu H., et al. // Phys. Rev. B. 1996. V. 53. № 11. P. 7287.

---

*Королев Никита Викторович* — аспирант кафедры физики полупроводников и микроэлектроники, Воронежский государственный университет; тел.: (920) 4113957, e-mail: korolevn33@yandex.ru

*Стародубцев Сергей Евгеньевич* — аспирант кафедры физики полупроводников и микроэлектроники, Воронежский государственный университет; тел.: (908) 1435926, e-mail: starodubtcevs@yandex.ru.

*Бормонтов Евгений Николаевич* — д.ф.-м.н., профессор кафедры физики полупроводников и микроэлектроники, Воронежский государственный университет; тел.: (473) 2208633, e-mail: me144@phys.vsu.

*Клинских Александр Федотович* — д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики, Воронежский государственный университет; тел. (473) 2208756, e-mail: klinskikh@live.ru.

*Korolev Nikita V.* — post graduate student, Department of Physic of Semiconductor and Microelectronics, Voronezh State University; tel.: (920) 4113957, e-mail: korolevn33@yandex.ru

*Starodubtcev Sergey E.* — post graduate student, Department of Physic of Semiconductor and Microelectronics, Voronezh State University; tel.: (908) 1435926, e-mail: starodubtcevs@yandex.ru

*Bormontov Eugenie N.* — Dr. Sci. (Phys.–Math.), Professor, Department of Physic of Semiconductor and Microelectronics, Voronezh State University; tel.: (473) 2208633, e-mail: me144@phys.vsu.

*Klinskikh Alexander F.* — Dr. Sci. (Phys.–Math.), Professor, Department of Theoretical Physics, Voronezh State University; tel.: (473) 2208756, e-mail: klinskikh@live.ru.